

Галузь застосування - пристрій для заряджання акумуляторів.

Призначення - формування постійної напруги та постійного струму.

Вид технології - технологія виготовлення ІМС з біполярними транзисторами, йоннолегованими резисторами, МОН-конденсаторами; ізоляція елементів Р-N-переходом.

Ознакою топографії, яка є новизною і є предметом заявки, є оригінальність конструкції елементів схеми електричної ІМС і оригінальність розташування елементів на кристалі ІМС.

Оригінальність конструкції елементів і їх розташування на кристалі ІМС забезпечили необхідні електричні параметри ІМС при більшій щільності упаковки кристала, тобто дозволили збільшити число елементів схеми, що розміщуються на одиниці площі кристала. Кінцевим результатом такого підходу є зменшення габаритів кристала. Економічний ефект полягає в збільшенні зйому придатних кристалів з однієї платівки при незмінних витратах робочого часу, енергоресурсів і витратних матеріалів. Все це призводить до зниження собівартості кристала.

Основні технічні характеристики кристала:

- напруга живлення - від 2,5 В до 12 В;

- струм живлення - до 2 мА.